

Транзисторы KT840A, KT840B предназначены для работы в высоковольтных импульсных схемах. Рекомендуется использовать в ключевых источниках питания телевизоров.

Si-n-p-n-MP

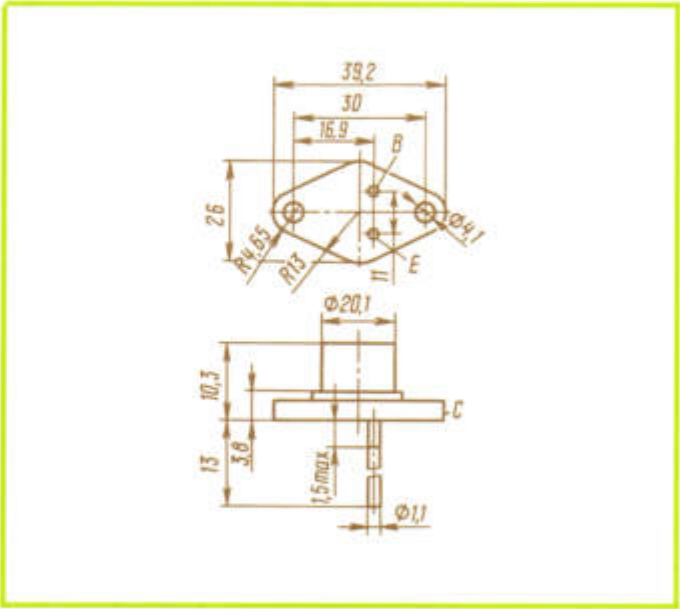
The KT840A, KT840B transistors are designed for use in high-voltage pulse circuits. They can also be used in switching power supplies for TV systems.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -45...+100^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

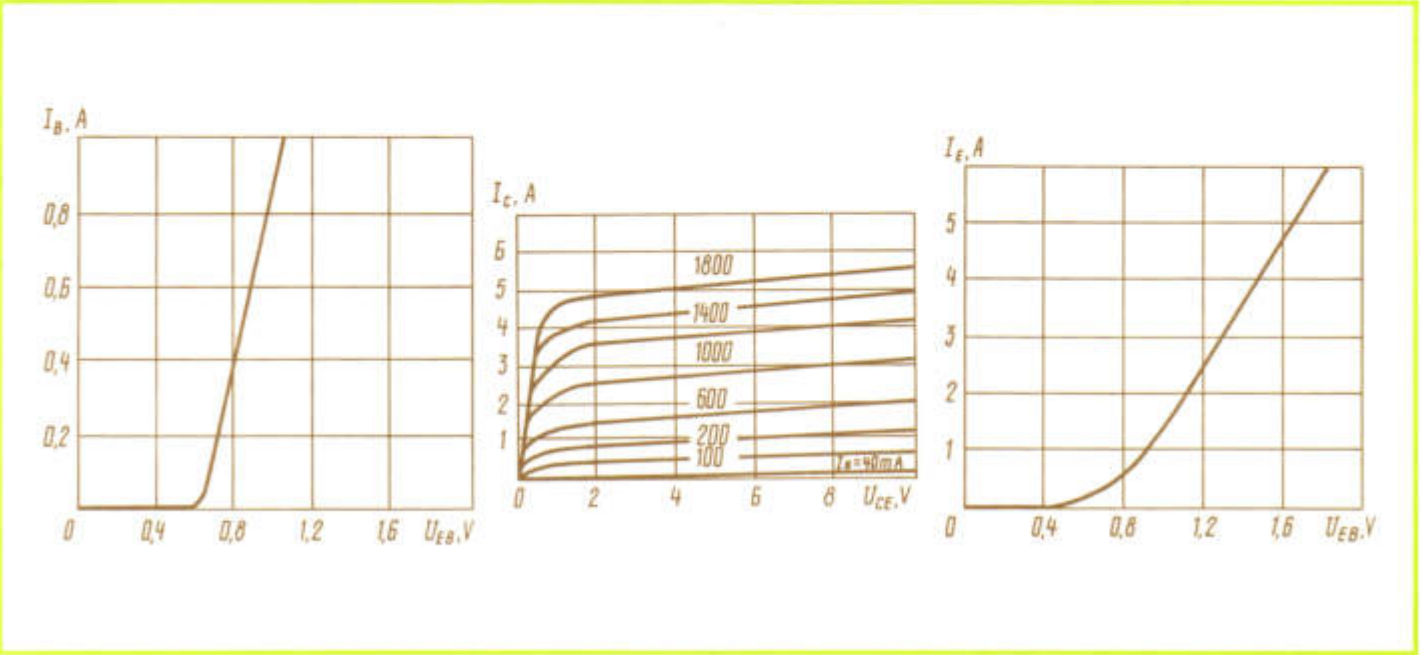
$U_{CE\ max.}$ ($R_B = 100\ \Omega$), V:	
KT840A	400
KT840B	350
$U_{CEM\ max.}$ ($t_p \leq 80\ \mu s, Q \geq 2$), V:	
KT840A	900
KT840B	750
$U_{EB\ max.}$, V	5
$I_C\ max.$, A	6
$I_{CM\ max.}$ ($t_p \leq 20\ \mu s, Q \geq 3$), A	8
$I_B\ max.$, A	2
$P_C\ max.$ ($t_{case} \leq 50^{\circ}C$), W	60
$t_j\ max.$, $^{\circ}C$	150
При $t_{case} > 50^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max.} = \frac{150 - t_{case}}{1.67}$	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT840A	KT840B	Режимы Conditions
1	2	3	4
I_{CBO} , mA	≤ 3	≤ 3	$U_{CB} = 900\ V$ $U_{CB} = 750\ V$
I_{EBO} , mA	≤ 50		$U_{EB} = 5\ V$



1	2	3	4
h_{21E}	10-100		$U_{CB} = 5\ V$ $I_E = 0.6\ A$
$U_{CE\ sat}$, V	≤ 3		$I_C = 4\ A$
$U_{BE\ sat}$, V	≤ 1.6		$I_B = 1.25\ A$
$ h_{21e} $	≥ 8		$U_{CE} = 10\ V$ $I_C = 200\ mA$
$U_{(L)\ CEO}$, V	400	350	$I_C \geq 100\ mA$
C_c , pF	≤ 60		$U_{CB} = 100\ V$ $f = 10\ MHz$



KT840A, KT840Б

